



Транзистор КТ827А, КТ827Б, КТ827В

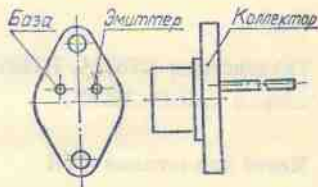


ЭТИКЕТКА

Кремниевые меза-плоскостные p-n-p мощные транзисторы КТ827А, КТ827Б, КТ827В в металлокерамическом корпусе КТ-9 ГОСТ 18472-83 предназначены для работы в усилителях низкой частоты, стабилизаторах тока и напряжения, импульсных усилителях мощности, повторителях, переключателях, в электронных системах управления, защиты и автоматики аппаратуры.

Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 3.1, 5.1.

Масса транзистора не более 20 г



Основные электрические параметры при T корп. = (25 ± 10)°C

Табл. 1

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначен.	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока Uкэ=3 В, Iк=10 А Uкэ=3 В, Iк=20 А	h21э	750	18000
		100	—
Обратный ток эмиттера, мА Uэб=5 В	Iэбо	—	2
Обратный ток коллектора, мА	Iкбо	—	0,5
Uкб=100 В для КТ827А		—	0,5
Uкб=80 В для КТ827Б		—	0,5
Uкб=60 В для КТ827В		—	0,5
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В Iк=10 А Iб=0,04 А	Uкэ нас	—	2
Напряжение насыщения база-эмиттер, В Iк=20 А Iб=0,20 А	Uбэ нас	—	4
Граничное напряжение, В L=40 мГн, Iк=0,10 А	Uкэ отг	100	—
		80	—
		60	—
		—	—
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте f=10 МГц, Iк=10 А Uкэ=3 В	(h21э)	0,4	—

Содержание драгметаллов в 1000 транзисторов:

Золота — 19,090 г

Серебра —

Содержание цветных металлов в 1000 шт. транзисторов:

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса, г
Медь	МО6	2900

#### Сведения о приемке

Транзисторы КТ827А, КТ827Б, КТ827В соответствуют техническим условиям АА0.336.356ТУ.

Место для штампа ОТК

#### Указания по эксплуатации

Указания по применению и эксплуатации по ГОСТ 11630-84, ОСТН 336.907.0-79 с дополнениями, вложенными ниже.

Транзисторы необходимо применять с теплоотводами. Крепление транзистора к теплоотводу должно обеспечивать надежный тепловой контакт.

Для улучшения теплового контакта необходимо наносить на нижнее основание корпуса транзистора жидкость ПМС-100 ГОСТ 13032-77 или другую теплопроводящую смазку.

При пайке выводов температура корпуса транзистора не должна превышать 100°C.

Т. 5000 З. 17-91